This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1/3



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11014556

(43) Date of publication of application: 22.01.1999

(51)Int.Cl.

GO1N 21/88 GO1M 11/00 GO1R 31/00 G02F 1/13 GO2F 1/136 G09F 9/35

(21)Application number: 09168230

(71)Applicant:

FUJITSU LTD

(22) Date of filing: 25.06.1997

(72)Inventor:

NAGASE YOJI

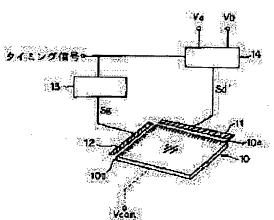
TANAKA YOSHINORI

(54) METHOD AND APPARATUS FOR INSPECTION OF TFT LIQUID-CRYSTAL **PANEL**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To discriminate the OFFdefect of a thin-film transistor(TFT) by a simple contrivance in an all-over turning-on inspection before a driver IC is attached.

SOLUTION: While a common TFT ON-test signal is being applied to all gate bus lines which are exposed on the short side 10b of a liquid-crystal substrate 10, a common display test signal is applied to all data bus lines which are exposed on the long side 16a of the liquid-crystal substrate 10, and the display state of all pixels on the liquid-crystal substrate 10 is inspected. At this time, the level of the display test signal is made different between the active period and the inactive period of the TFT ON-test signal. In the case



of a TFT in which an OFF-defect is generated, a pixel voltage is rewritten in the inactive period of the TFT ON-test signal, and the display level of a screen is changed. Consequently, when its change is confirmed visually, a defective pixel can be discriminated easily.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

MENU SEARCH INDEX DETAIL NEXT

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-14556

(43)公開日 平成11年(1999) 1月22日

(51) Int.Cl.*		識別記号		FΙ					
G01N	21/88			G 0	1 N	21/88		J	
G 0 1 M	11/00			G0	1 M	11/00		T	
G 0 1 R	31/00			G0	1 R	31/00			
G 0 2 F	1/13	101		G0.	2 F	1/13		101	•
	1/136	500				1/136		500	
			永镐査審	未請求	請才	≷項の数 2	OL	(全 6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧平9-168230		(71)出願人 000005223					
						富士通	•	-	
(22)出顧日		平成9年(1997)6月25日					川県川崎市中原区上小田中4丁目1番		
						1号			
				(72)	発明	音 長瀬	洋二		
					神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番				

(72)発明者

(54) 【発明の名称】 TFT液晶パネルの検査方法及びその装置

(57)【要約】

【課題】 ドライバICを取り付ける前のべた点灯検査において簡単な工夫でTFTのオフ欠陥を識別する。

【解決手段】 液晶基板の短辺側に露出した全てのゲートバスラインに共通のTFTオン試験信号を印加しながら液晶基板の長辺側に露出した全てのデータバスラインに共通の表示試験信号を印加して液晶基板の全ての画素の表示状態を検査する際に表示試験信号のレベルをTFTオン試験信号のアクティブ期間とインアクティブ期間とで異ならせる。オフ欠陥を生じたTFTの場合は、TFTオン試験信号のインアクティブ期間になると画素電圧が書き換えられてしまうために、画面の表示レベルが変化する。したがって、この変化を目視確認することにより、欠陥画素を容易に識別できる。

- 実施例の概念的な構成図

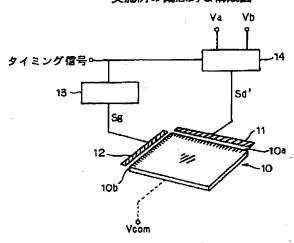
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

1号 富士通株式会社内

田中 義規

(74)代理人 弁理士 有我 軍一郎



S d': 表示試験信号 10: 液晶基板 10a: 長辺側 10b: 短辺側 11: データ用コンタクト (第2の手段、第3の手段 12: ゲート用コンタクト (第1の手段) 13: ゲート用信号発生器 (第1の手段) 14: データ用信号発生器 (第2の手段、第3の手段 10

【特許請求の範囲】

【請求項1】液晶基板の短辺側に露出した全てのゲートバスラインに共通のTFTオン試験信号を印加しながら、前記液晶基板の長辺側に露出した全てのデータバスラインに共通の表示試験信号を印加して、前記液晶基板の全ての画素の表示状態を検査する方法において、前記表示試験信号のレベルを前記TFTオン試験信号のアクティブ期間とインアクティブ期間とで異ならせたことを特徴とするTFT液晶パネルの検査方法。

【請求項2】液晶基板の短辺側に露出した全てのゲートバスラインに共通のTFTオン試験信号を印加するための第1の手段と、前記液晶基板の長辺側に露出した全てのデータバスラインに共通の表示試験信号を印加するための第2の手段と、前記表示試験信号のレベルを前記TFTオン試験信号のアクティブ期間とインアクティブ期間とで異ならせるための第3の手段と、を備えたことを特徴とするTFT液晶パネルの検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スイッチング素子 20 にTFT (thin film transistor: 薄膜トランジスタ) を用いたアクティブマトリクス方式の液晶パネル (以下、TFT液晶パネルと言う)の検査方法及びその装置に関し、特に、ドライバICを取り付ける前の段階で行われる "べた点灯検査"と呼ばれる検査方法及びその装置に関する。

【0002】TFT液晶パネルは、画素電極と対向電極との間に挟み込まれた液晶の配向を、両電極間の容量に書き込まれた電圧(以下、画素電圧と言う)で制御することによって所望の表示階調を得るというものである。TFTのスイッチング動作によって正確な画素電圧の書き込みが可能で、微妙な中間調を表示できるという特長があり、パーソナルコンピュータをはじめ様々な表示装置に多用されている。しかし、一方でTFTの製造欠陥に伴う歩留まりの低さという難点も持ち合わせており、歩留まり改善に寄与する有益な技術の提供が求められている。

[0003]

【従来の技術】一般に、TFT液晶パネルの歩留まりは、ドライバICを実装する前の工程のうちラピング工程と貼り合わせ工程が支配的である。ラピング工程では配向膜のこすり過ぎによって配向不良や光漏れを生じやすく或いは摩耗帯電によってTFTや配向膜が破壊しやすいからであり、また、貼り合わせ工程ではセル・ギャップが不均一になって表示ムラが生じやすいからである。ドライバICを実装する前の段階のTFT液晶パネルを便宜的に液晶基板と称すると、この液晶基板の欠陥は"べた点灯検査"と呼ばれる手法によってスクリーニングされていた。

【0004】図8において、1は液晶基板である。液晶

基板1は2枚のガラス板の一方にゲートバスラインとデータバスラインを交差配列すると共に各交差点にTFTと液晶電極を形成し、他方のガラス板に共通電極を形成した構造を有しており、図では各々一つのデータバスライン2、ゲートバスライン3、TFT4及び液晶電極5を代表的に示してある。液晶基板1の少なくとも2辺にはそれぞれゲートバスラインとデータバスラインの先端が露出している。この露出部分にTAB(tapeautomated bonding)によってドライバICを実装することになるが、現段階ではまだドライバICは取り付けられていない。

【0005】従来のべた点灯検査は、全てのゲートバスラインに共通のTFTオン試験信号Sgを加えながら、全てのデータバスラインに共通の表示試験信号Sdを加えるというものである。なお、共通電極の電位(Vcom)は省略してある。Sgの1周期Tgは当該液晶基板1の水平走査周波数の周期にほぼ相当し、例えば60Hzの表示画像であればTgは16.6msになる。Sgのアクティブ期間のレベルはTFT4のしきい値を十分に超える大きさに設定されており、このアクティブ期間でTFT4がオンするようになっている。一方、Sdは任意の一つの表示階調(典型的には黒レベル又は白レベル)に対応した電位レベルに設定されており、且つ、液晶劣化防止のために、Vcomを中心にTgの周期で正負交互に交流駆動されている。

【0006】Sdの階調を黒レベルにすると液晶基板1の全面が黒表示になり、逆に白レベルにすると液晶基板1の全面が白表示になる。したがって、前者では欠陥画素が白く見え、後者では欠陥画素が黒く見えるから、欠陥の程度によって液晶基板1の良・不良を判定できる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる 従来のべた点灯検査にあっては、TFTのオフ欠陥(不 完全なオフ状態;具体的にはソースードレイン間が小さ な抵抗値でつながった状態)があった場合、液晶基板 1 の表示状態からはこの欠陥を見つけ出すことができない という問題点があった。

【0008】すなわち、正常なTFTの場合はSgのアクティブ期間でオン状態となってSdのレベルを画素電 極5に書き込み、Sgの立ち下がりと同時にオフ状態となって次回のSgの立ち上がりまでの間その書き込み電位を保持するが、オフ欠陥を生じたTFTの場合はSgが立ち下がってもオフ状態にならないため、Sdが継続的に液晶電極5に書き込まれてしまう。何れの場合も液晶基板1の表示状態はまったく同じであり、正常なTFTとオフ欠陥を生じたTFTの見分けが付かない。

【0009】なお、TFTのオフ欠陥は、全てのゲートバスラインに一度にSgを与えるのではなく、ゲートバスラインを線順次に選択しながらSgを順番に与えることによって識別できる。例えば、i行目のゲートバスラ

3

インにSgを与えたときに、i行目以外の画素が表示(Sdのレベル)された場合は、その画素のTFTにオフ欠陥が生じていることを識別できる。

【0010】但し、そのためには、液晶基板1のゲートバスラインの一本一本と電気的なコンタクトをとる必要があるが、ゲートバスラインのピッチはきわめて狭いため、コンタクト用治具の工作精度や位置合わせ精度を十分なものにしなければならず、結局、検査コストのアップにつながってしまう。そこで、本発明は、ドライバICを取り付ける前のべた点灯検査において、簡単な工夫でTFTのオフ欠陥を識別することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶基板の短辺側に露出した全てのゲートバスラインに共通のTFTオン試験信号を印加しながら、前記液晶基板の長辺側に露出した全てのデータバスラインに共通の表示試験信号を印加して、前記液晶基板の全ての画素の表示状態を検査する際に、前記表示試験信号のレベルを前記TFTオン試験信号のアクティブ期間とインアクティブ期間とで異ならせたことを特徴とするものである。

【0012】説明の都合上、TFTオン試験信号のアクティブ期間における表示試験信号のレベルをVa、TFTオン試験信号のインアクティブ期間における表示試験信号のレベルをVbとすると、正常なTFTの場合は、TFTオン試験信号のアクティブ期間に書き込まれた画素電圧(Va)をTFTオン試験信号のインアクティブ期間の間保持するため、画面の表示レベルはVaに対応したものになるが、オフ欠陥を生じたTFTの場合は、TFTオン試験信号のインアクティブ期間になると画素電圧がVbに書き換えられてしまうために、画面の表示レベルがVaからVbへと変化する。したがって、この変化を目視確認することにより、欠陥画素を容易に識別できる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図1、図2は本発明に係るTFT液晶パネルの検査方法及びその装置の一実施例を示す図である。図1において、10はドライバICを取り付ける前の液晶基板(従来の液晶基板1に相当)であり、11は液晶基板10の長辺側10aに露出した全てのデータバスラインに電気的に接続するデータ用コンタクト、12は液晶基板10の短辺側10bに露出した全てのゲートバスラインに電気的に接続するゲート用コンタクトである。なお、データ用コンタクト11及びゲート用コンタクト12は液晶基板10から離れているが、これは図示の都合である。

【0014】13はゲート用信号発生器、14はデータ 用信号発生器である。これらの信号発生器13、14 は、所定のタイミング信号(液晶基板10の表示信号に 対応した水平垂直同期信号やクロック信号など)に同期 した試験信号を発生してゲート用コンタクト11やデータ用コンタクト12に印加するためのものであり、ゲート用信号発生器13とゲート用コンタクト12は一体として特許請求の範囲に記載の"第1の手段"を構成し、また、データ用信号発生器14とデータ用コンタクト11は一体として特許請求の範囲に記載の"第2の手段"及び"第3の手段"を構成する。

【0015】ゲート用信号発生器13からゲート用コン タクト12に印加されるTFTオン試験信号Sgは従来 例と同様であるが、データ用信号発生器14からデータ 用コンタクト11に印加される表示用試験信号Sd' は、以下の点で従来例と相違する。すなわち、図2は本 実施例のSg及びSd'の波形図であり、Sgは、従来 例と同様に一つの周期Tgにアクティブ期間(TFTの しきい値を上回るレベルの期間) とインアクティブ期間 (TFTのしきい値を下回るレベルの期間)を含むが、 Sd'は、Sgのアクティブ期間のレベル (便宜的にV a)と同インアクティブ期間のレベル (便宜的に Vb) とで異なっている。なお、液晶の劣化防止のために交流 20 駆動を行うのは当然であり、本実施例のVa及びVbも comを中心にしてTgの周期で正負(Va、Vbの後 のマイナス記号は負極性を表わしている)に振ってい る。

【0016】このような構成において、正常なTFTの場合は、Sgのアクティブ期間でオン状態となってVaを画素電極に書き込んだ後、Sgのインアクティブ期間でオフ状態となって書き込まれたVaをそのまま保持する。このため、Sgのインアクティブ期間におけるVbは何ら表示に影響しない。例えば、Vaを黒レベルとすれば、画面表示は黒のままである。

【0017】これに対して、オフ欠陥を生じたTFTの場合は、Sgのインアクティブ期間で完全なオフ状態とならないため、この欠陥TFTを通して画素電圧がVaからVb(又はVbに近いレベル)へと書き換えられてしまう。したがって、例えば、Vaを黒レベル、Vbを白レベルとすれば、画面表示が当該欠陥部分で黒から白に変化するので、容易に欠陥を識別できる。

【0018】なお、図2の例では、Sgのアクティブ期間のSd'をVa、インアクティブ期間のSd'をVbとし、且つ、Va>Vb>Vcom(負極性側ではVa<(Vb)</br> (Vb)</br> (Vb)</br> (Vcom)</br> (Vcom)
 (Vcom)

10

5

できる程度に検査時間が短い場合は、図6や図7に示すように、交流駆動を行わず全ての周期でVa>Vb>V com又はVa>Vb=V com(図7ではVa(-) < Vb(-) < Vcom又はVa(-) < Vb(-) = Vcom) としてもよい。

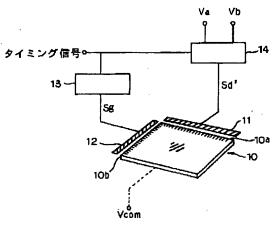
【0019】また、VaやVbに対応する階調レベルも、大きなコントラスト比を得るという観点から当然、一方を最大の階調レベル、他方を最小の階調レベルとすべきであるが、十分な識別性能が得られるのであれば、適宜の中間調をVaやVbに割当てても構わない。 【0020】

【発明の効果】本発明によれば、全てのデータバスラインに印加する表示試験信号のレベルを、TFTオン試験信号のアクティブ期間とインアクティブ期間とで異ならせるという簡単な工夫だけで、オフ欠陥を生じたTFTの画素を間違いなく識別することができ、不良の液晶基板をべた点灯検査の段階で確実にスクリーニングできる。

【0021】そして、このことにより、ドライバICの無用な破棄を回避して製造コストを大幅に抑制できるというTFT液晶パネルの分野にとってきわめて有益な効果が得られる。その理由は、従来技術では、ドライバICを取り付けた後の検査でしかオフ欠陥を生じたTFTを見つけ出すことができなかったからであり、一旦取り

【図1】

一実施例の概念的な構成図



S g: TFTオン試験信号 S d': 表示試験信号 10:液晶基板 10a: 液晶基板 10a: 長辺側 11b: 短辺側 11: データ用コンタクト (第2の手段、第3の手段) 12: ゲート用コンタクト (第1の手段) 13: ゲート用信号発生器 (第1の手段) 14: データ用信号発生器 (第2の手段、第3の手段) 付けたドライバICを取り外すには相応の手間とコストがかかるため、不本意ながら液晶ユニット全体を破棄せざるを得なかったからである。

【図面の簡単な説明】

【図1】一実施例の概念的な構成図である。

【図2】一実施例の信号波形図である。

【図3】一実施例の他の信号波形図(その1)である。

【図4】一実施例の他の信号波形図 (その2) である。

【図5】一実施例の他の信号波形図(その3)である。

【図6】一実施例の他の信号波形図(その4)である。

【図7】一実施例の他の信号波形図(その5)である。

【図8】従来のべた点灯検査の概念図である。

【符号の説明】

Sg:TFTオン試験信号

Sd':表示試験信号

2:データバスライン

3:ゲートバスライン

10:液晶基板

10a:長辺側

) 10b:短辺側

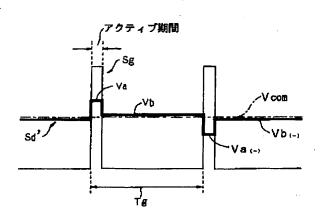
11:データ用コンタクト (第2の手段。第3の手段)

12: ゲート用コンタクト (第1の手段) 13: ゲート用信号発生器 (第1の手段)

14:データ用信号発生器 (第2の手段。第3の手段)

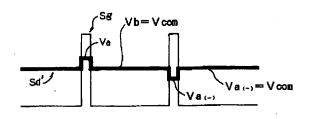
【図2】

一実施例の信号波形図



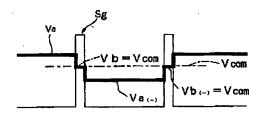
【図3】

一実施例の他の信号波形図(その1)



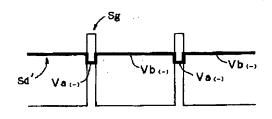
【図5】

一実施例の他の信号波形図(その3)



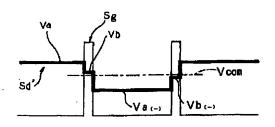
【図7】

一実施例の他の信号波形図(その5)



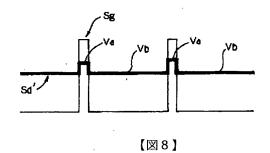
【図4】

一実施例の他の信号波形図(その2)

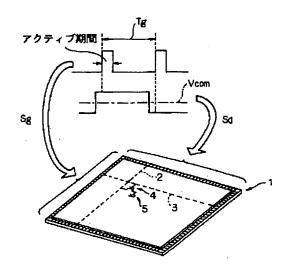


【図6】

一実施例の他の信号波形図(その4)



従来のべた点灯検査の概念図



2:データパスライン3・ゲートパスライン

(6)

特開平11-14556

フロントページの続き

(51)Int.Cl.6
G 0 9 F 9/35

識別記号 302 FΙ

G09F 9/35

302